

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-204524

(43)Date of publication of application : 30.07.1999

(51)Int.Cl.

H01L 21/3205

(21)Application number : 10-004004

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRON CORP

(22)Date of filing : 12.01.1998

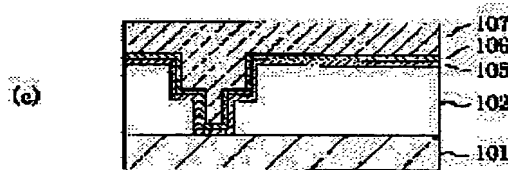
(72)Inventor : SEKIGUCHI MITSURU

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE OF THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high semiconductor device with high reliability having embedded wiring in which conductivity and electromigration resistance is satisfactory.

SOLUTION: A contact hole 103 and a recessed groove 104 for wiring are formed on an interlayer insulating film 102 accumulated on a semiconductor substrate 101, and then a TiN/Ti film 105 which is a diffusion preventing film is formed on the wall face of the contact hole 103 and the recessed groove 104 for wiring. A copper alloy film 106, in which Ag is included in Cu is accumulated on the TiN/Ti film 105 through sputtering method, and a copper film 107 is accumulated on the copper alloy film 106 by a CVD method or a plating method. Then, Ag included in the copper alloy film 106 is diffused to the copper film 107 by heat treatment, so that the copper alloy film in which Ag is included in Cu can be formed. Then, the contact and the embedded wiring constituted of the copper alloy, in which Ag is included in Cu can be simultaneously formed by operating a CMP method to the copper alloy film.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.01.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3040745

[Date of registration]

03.03.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-204524

(43) 公開日 平成11年(1999) 7月30日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 1 L 21/3205

識別記号

F I

H 0 1 L 21/88

M

R

審査請求 有 請求項の数10 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願平10-4004

(22) 出願日 平成10年(1998) 1月12日

(71) 出願人 000005843

松下電子工業株式会社

大阪府高槻市幸町1番1号

(72) 発明者 関口 満

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業
株式会社内

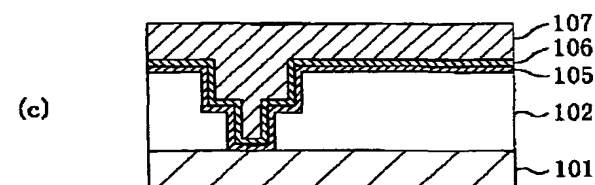
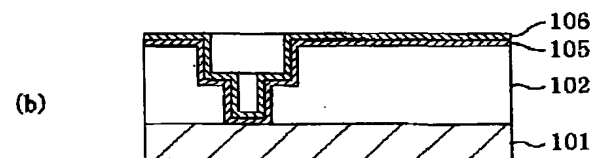
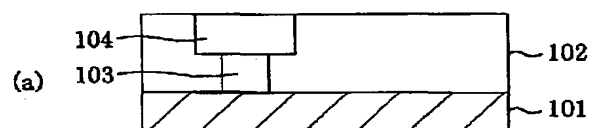
(74) 代理人 弁理士 前田 弘 (外2名)

(54) 【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 導電率及びエレクトロマイグレーション耐性に優れた埋め込み配線を有する信頼性の高い半導体装置を提供する。

【解決手段】 半導体基板101の上に堆積された層間絶縁膜102にコンタクトホール103及び配線用凹状溝104を形成した後、コンタクトホール103及び配線用凹状溝104の壁面に拡散防止膜となるTiN/Ti膜105を形成する。TiN/Ti膜105の上にスパッタ法によりCuにAgが含有された銅合金膜106を堆積した後、該銅合金膜106の上にCVD法又はメッキ法により銅膜107を堆積する。熱処理により銅合金膜106に含まれるAgを銅膜107に拡散させてCuにAgが含有されてなる銅合金膜を形成した後、該銅合金膜に対してCMP法を行なって、CuにAgが含有されてなる銅合金膜よりなるコンタクト及び埋め込み配線を同時に形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 埋め込み配線を有する半導体装置であって、
前記埋め込み配線は、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された銅合金よりなることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記銅合金は、Cuに1重量%以下のAgが含有されてなることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 前記銅合金は、Cuに0.4重量%以下のNbが含有されてなることを特徴とする半導体装置。

【請求項4】 埋め込み配線と該埋め込み配線の上に形成された絶縁膜とを有する半導体装置であって、
前記絶縁膜は、Al₂O₃を含有し、
前記埋め込み配線は、Cuに前記Al₂O₃が拡散してなる銅合金よりなることを特徴とする半導体装置。

【請求項5】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、
前記配線用凹部の壁面にCuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された第1の金属よりなる第1の金属膜を形成する第1の金属膜形成工程と、
前記第1の金属膜の上にCu又はCuを主成分とする第2の金属よりなる第2の金属膜を前記配線用凹部が埋め込まれるように形成する第2の金属膜形成工程と、
前記半導体基板に対して熱処理を行なって前記第1の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl₂O₃を前記第2の金属膜に拡散させることにより、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項6】 前記第1の金属膜形成工程は、前記配線用凹部を含む前記層間絶縁膜の上に全面に亘って前記第1の金属膜を堆積する工程を含み、
前記第2の金属膜形成工程は、前記第1の金属膜の上に全面に亘って前記第2の金属膜を堆積する工程を含み、
前記埋め込み配線形成工程は、前記層間絶縁膜の上に露出している前記第1の金属膜及び第2の金属膜を除去する工程を含むことを特徴とする請求項5に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項7】 前記第1の金属膜形成工程は、スパッタ法により前記第1の金属膜を堆積する工程を含み、
前記第2の金属膜形成工程は、CVD法又はメッキ法により前記第2の金属膜を堆積する工程を含むことを特徴とする請求項5に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項8】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、
前記配線用凹部を含む前記層間絶縁膜の上にCu又はCuを主成分とする第1の金属よりなる第1の金属膜を前記配線用凹部が埋め込まれるように全面に亘って形成する第1の金属膜形成工程と、

前記第1の金属膜の上にAg、Nb又はAl₂O₃を含有する第2の金属よりなる第2の金属膜を形成する第2の金属膜形成工程と、

前記半導体基板に対して熱処理を行なって前記第2の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl₂O₃を前記第1の金属膜に拡散させる拡散工程と、

前記層間絶縁膜の上に露出している前記第1の金属膜及び第2の金属膜を除去して、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項9】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、

前記配線用凹部にCu又はCuを主成分とする第1の金属よりなる第1の金属膜を該第1の金属膜の上に空間部が残存するように形成する第1の金属膜形成工程と、

前記第1の金属膜の上にAg、Nb又はAl₂O₃が含有された第2の金属よりなる第2の金属膜を前記空間部が埋め込まれ且つ前記層間絶縁膜の上に露出しないように形成する第2の金属膜形成工程と、

前記半導体基板に対して熱処理を行なって前記第2の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl₂O₃を前記第1の金属膜に拡散させることにより、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項10】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、

前記配線用凹部にCu又はCuを主成分とする第1の金属よりなる第1の金属膜を前記配線用凹部が埋め込まれ且つ前記層間絶縁膜の上に露出しないように形成する第1の金属膜形成工程と、

前記第1の金属膜の上にAg、Nb又はAl₂O₃を含有する第2の金属よりなる第2の金属膜を形成する第2の金属膜形成工程と、

前記半導体基板に対して熱処理を行なって前記第2の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl₂O₃を前記第1の金属膜に拡散させることにより、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、埋め込み配線を有する半導体装置及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】0.18μm世代以降のシリコン基板上に形成されたLSIにおいては、トランジスタの高速化に対して配線のCR成分による遅延が無視できなくなってきたため、配線材料として、導電性の高い金属つまり

比抵抗の小さい金属を用いることが好ましい。そこで、Al配線（比抵抗 $3\mu\text{ohm}\cdot\text{cm}$ ）に代えて、より低抵抗なCu配線（比抵抗 $1.7\mu\text{ohm}\cdot\text{cm}$ ）を用いる検討が進んでいる。

【0003】また、LSIを構成する素子の微細化に伴って金属配線を通る電流の密度が世代ごとに増加しているため、電流印加時に金属配線を構成する金属原子が電子に押されて移動して、金属配線が断線してしまうエレクトロマイグレーションという現象に対しても、その耐性を高めていく必要がある。CuはAlに比べて融点が高いため、変形すなわち原子の移動が起こりにくくことが期待されており、エレクトロマイグレーション耐性も高いことが期待されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところが、Cuよりなる金属配線は、導電率については極めて優れているが、配線幅がより微細になると、エレクトロマイグレーション耐性という点では問題が残ると考えられる。例えば、 $0.3\mu\text{m}$ 幅程度の微細な金属配線では、エレクトロマイグレーション耐性が悪化すると報告されている[Y. Igarashi et al, VLSI Symp., p.76, 1996]。従って、Al配線の場合と同様、合金化によってエレクトロマイグレーション耐性を向上させることが検討されている。

【0005】そこで、配線材料として、Cu-Mg合金[T. Tatewaki et al, IEDM., p.293, 1995]、Cu-Zr合金[Y. Igarashi et al, VLSI Symp., p.76, 1996]、Cu-Sn合金等が提案されている。

【0006】しかしながら、Cu-Mg合金、Cu-Zr合金又はCu-Sn合金等の銅合金よりなる配線は、エレクトロマイグレーション耐性という点では優れているが、導電率という点では問題が残る。

【0007】前記に鑑み、本発明は、導電率の向上とエレクトロマイグレーション耐性の向上との両立を図ることができる配線材料を提供することにより、導電率及びエレクトロマイグレーション耐性に優れた埋め込み配線を有する信頼性の高い半導体装置を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】本願発明者は、引張り強さの大きい材料はエレクトロマイグレーション耐性にも優れているはずであると考えた。その理由は、銅合金配線に電流を流したときに、銅合金配線を構成する銅原子が移動する結果として、銅原子が増加した部位では圧縮応力が増加する一方、銅原子が減少した部位においては引張り応力が発生し、銅原子が減少した部位において銅合金配線が断線するのである。従って、引張り強さが大きい銅合金はエレクトロマイグレーション耐性が優れているはずである。そこで、引張り強さ及び導電率の両方に優れた銅合金を配線材料として用いると、導電率及びエレクトロマイグレーション耐性に優れた信頼性の高い

銅合金配線が得られる筈であるとの結論に達したのである。

【0009】各種の銅合金のうち、引張り強さ及び導電率の両方に優れた銅合金を探し求めたところ図8に示すデータ（坂井他、まてりあ、p.692、1997）を見出した。図8に示す特性図によると、Cu-Nb合金、Cu-Ag合金及びCu-Al₂O₃合金は、各種の銅合金のうち、引張り強さ及び導電率の両方に優れた銅合金であることを見出した。尚、図8において、%IACSは、純銅の導電率に対する導電率の割合を示している。

【0010】以上の検討から分かるように、CuにNb、Ag又はAl₂O₃が含まれた銅合金を用いて埋め込み配線を形成すると、導電率及びエレクトロマイグレーション耐性に優れた信頼性の高い半導体装置が得られるのである。

【0011】本発明に係る第1の半導体装置は、埋め込み配線を有する半導体装置を対象とし、埋め込み配線は、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された銅合金よりなる。

【0012】第1の半導体装置によると、埋め込み配線はCuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有されてなるCu-Nb合金、Cu-Ag合金又はCu-Al₂O₃合金よりなり、これらCu-Nb合金、Cu-Ag合金及びCu-Al₂O₃合金は図8の特性図に示すように、引張り強さ及び導電率の両方に優れている。

【0013】第1の半導体装置において、銅合金は、Cuに1重量%以下のAgが含有されてなることが好ましい。

【0014】また、第1の半導体装置において、銅合金は、Cuに0.4重量%以下のNbが含有されてなることが好ましい。

【0015】本発明に係る第2の半導体装置は、埋め込み配線と該埋め込み配線の上に形成された絶縁膜とを有する半導体装置を対象とし、絶縁膜はAl₂O₃を含有し、埋め込み配線はCuにAl₂O₃が拡散してなる銅合金よりなる。

【0016】第2の半導体装置によると、埋め込み配線はCuにAl₂O₃が含有されてなるCu-Al₂O₃合金よりなり、このCu-Al₂O₃合金は図8の特性図に示すように、引張り強さ及び導電率の両方に優れている。また、埋め込み配線の上に形成された絶縁膜はAl₂O₃を含有するため、絶縁膜に含有されるAl₂O₃を埋め込み配線に拡散させてCuにAl₂O₃が含有されてなるCu-Al₂O₃合金を容易に形成することができる。この場合、Al₂O₃は絶縁性を有しているため、そのまま絶縁膜として用いることもできる。

【0017】本発明に係る第1の半導体装置の製造方法は、半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、配線用凹部の壁面にCuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された第1の金属より

なる第1の金属膜を形成する第1の金属膜形成工程と、第1の金属膜の上にCu又はCuを主成分とする第2の金属よりなる第2の金属膜を配線用凹部が埋め込まれるように形成する第2の金属膜形成工程と、半導体基板に対して熱処理を行なって第1の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl、O₂を第2の金属膜に拡散させることにより、CuにAg、Nb又はAl、O₂が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えている。

【0018】第1の半導体装置の製造方法によると、層間絶縁膜に形成された配線用凹部の壁面にCuにAg、Nb又はAl、O₂が含有された第1の金属よりなる第1の金属膜を形成した後、該第1の金属膜の上にCu又はCuを主成分とする第2の金属よりなる第2の金属膜を形成し、その後、熱処理を行なって第1の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl、O₂を第2の金属膜に拡散させるため、CuにAg、Nb又はAl、O₂が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成することができる。

【0019】ところで、Cu又はCuを主成分とする銅系の金属膜はドライエッチングが困難であるため、埋め込み配線は、層間絶縁膜に配線用凹部を形成しておいてから、配線用凹部に銅系の金属膜を埋め込むダマシン法によって形成されることが多いが、第1の半導体装置の製造方法によると、CuにAg、Nb又はAl、O₂が含有された銅合金よりなる埋め込み配線をダマシン法により形成することができる。また、配線用凹部の下側にコンタクトホールを形成しておいてから、コンタクトホール及び配線用凹部の両方に同時に金属膜を埋め込むようにすると、デュアルダマシン法によって銅合金よりなるコンタクト及び埋め込み配線を同時に形成することができる。

【0020】第1の半導体装置の製造方法において、第1の金属膜形成工程は、配線用凹部を含む層間絶縁膜の上に全面に亘って第1の金属膜を堆積する工程を含み、第2の金属膜形成工程は、第1の金属膜の上に全面に亘って第2の金属膜を堆積する工程を含み、埋め込み配線形成工程は、層間絶縁膜の上に露出している第1の金属膜及び第2の金属膜を除去する工程を含むことが好ましい。

【0021】第1の半導体装置の製造方法において、第1の金属膜形成工程は、スパッタ法により第1の金属膜を堆積する工程を含み、第2の金属膜形成工程は、CVD法又はメッキ法により第2の金属膜を堆積する工程を含むことが好ましい。

【0022】ところで、デザインルールが0.18μmの世代では、コンタクトホールが0.25μm径で且つ0.8μm程度の深さになり、配線用凹部についても0.5μm程度の深さが必要になると予測される。このような微細な配線構造をデュアルダマシン法を用いて形

成しようとする、深さが1.3μm程度で径が0.25μm程度の孔（アスペクト比が5程度の孔）に銅合金を埋め込む必要がある。ところが、現在の技術によると、CVD法及びメッキ法では純銅の金属膜を堆積することはできるが銅合金の金属膜を堆積することはできない。また、スパッタ法によると銅合金の金属膜を堆積することはできるが、アスペクト比の高い配線用凹部に堆積しようとする、オーバーハングが発生してしまうため、アスペクト比の高い配線用凹部にスパッタ法により金属膜を埋め込むことは困難である。

【0023】ところが、第1の金属膜形成工程がスパッタ法により第1の金属膜を堆積する工程を含み、第2の金属膜形成工程がCVD法又はメッキ法により第2の金属膜を堆積する工程を含むと、配線用凹部の壁面にCuにAg、Nb又はAl、O₂が含有された第1の金属よりなる第1の金属膜をスパッタ法により形成した後、Cu又はCuを主成分とする第2の金属よりなる第2の金属膜を段差被覆性に優れたCVD法又はメッキ法により堆積するので、配線用凹部に第1の金属膜及び第2の金属膜を埋め込むことができる。

【0024】本発明に係る第2の半導体装置の製造方法は、半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、配線用凹部を含む層間絶縁膜の上にCu又はCuを主成分とする第1の金属よりなる第1の金属膜を配線用凹部が埋め込まれるように全面に亘って形成する第1の金属膜形成工程と、第1の金属膜の上にAg、Nb又はAl、O₂を含有する第2の金属よりなる第2の金属膜を形成する第2の金属膜形成工程と、半導体基板に対して熱処理を行なって第2の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl、O₂を第1の金属膜に拡散させる拡散工程と、層間絶縁膜の上に露出している第1の金属膜及び第2の金属膜を除去して、CuにAg、Nb又はAl、O₂が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えている。

【0025】第2の半導体装置の製造方法によると、層間絶縁膜に形成された配線用凹部を含む層間絶縁膜の上にCu又はCuを主成分とする第1の金属よりなる第1の金属膜を形成した後、該第1の金属膜の上にAg、Nb又はAl、O₂を含有する第2の金属よりなる第2の金属膜を形成し、その後、熱処理を行なって第2の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl、O₂を第1の金属膜に拡散させるため、CuにAg、Nb又はAl、O₂が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成することができる。

【0026】特に、第2の半導体装置の製造方法は、配線用凹部が埋め込まれるように全面に亘って第1の金属膜を形成した後、該第1の金属膜の上に第2の金属膜を形成するため、第2の金属膜の表面はほぼ平坦である。従って、第2の金属膜からのAg、Nb又はAl、O₂

10

20

30

40

50

の拡散をより均一に行なうことができる。

【0027】本発明に係る第3の半導体装置の製造方法は、半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、配線用凹部にCu又はCuを主成分とする第1の金属よりなる第1の金属膜を該第1の金属膜の上に空間部が残存するように形成する第1の金属膜形成工程と、第1の金属膜の上にAg、Nb又はAl₂O₃が含有された第2の金属よりなる第2の金属膜を空間部が埋め込まれ且つ層間絶縁膜の上に露出しないように形成する第2の金属膜形成工程と、半導体基板に対して熱処理を行なって第2の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl₂O₃を第1の金属膜に拡散させることにより、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えている。

【0028】第3の半導体装置の製造方法によると、層間絶縁膜に形成された配線用凹部にCu又はCuを主成分とする第1の金属よりなる第1の金属膜を形成した後、該第1の金属膜の上にAg、Nb又はAl₂O₃が含有された第2の金属よりなる第2の金属膜を形成し、その後、熱処理を行なって第2の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl₂O₃を第1の金属膜に拡散させるため、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成することができる。

【0029】特に、第3の半導体装置の製造方法によると、配線用凹部に第1の金属膜を該第1の金属膜の上に空間部が残存するように形成した後、該第1の金属膜の上に第2の金属膜を空間部が埋め込まれ且つ層間絶縁膜の上に露出しないように形成し、その後、熱処理を行なうので、層間絶縁膜の上に露出した第1及び第2の金属膜を除去する工程が不要になる。

【0030】本発明に係る第4の半導体装置の製造方法は、半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、配線用凹部にCu又はCuを主成分とする第1の金属よりなる第1の金属膜を配線用凹部が埋め込まれ且つ層間絶縁膜の上に露出しないように形成する第1の金属膜形成工程と、第1の金属膜の上にAg、Nb又はAl₂O₃を含有する第2の金属よりなる第2の金属膜を形成する第2の金属膜形成工程と、半導体基板に対して熱処理を行なって第2の金属膜に含有されているAg、Nb又はAl₂O₃を第1の金属膜に拡散させることにより、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えている。

【0031】第4の半導体装置の製造方法によると、層間絶縁膜に形成された配線用凹部にCu又はCuを主成分とする第1の金属よりなる第1の金属膜を形成した後、該第1の金属膜の上にAg、Nb又はAl₂O₃を含有する第2の金属よりなる第2の金属膜を形成し、その後、熱処理を行なって第2の金属膜に含有されている

Ag、Nb又はAl₂O₃を第1の金属膜に拡散させるため、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成することができる。

【0032】特に、第4の半導体装置の製造方法によると、配線用凹部に第1の金属膜を配線用凹部が埋め込まれ且つ層間絶縁膜の上に露出しないように形成した後、該第1の金属膜の上に第2の金属膜を形成するため、第2の金属膜の表面はほぼ平坦である。

【0033】

10 【発明の実施の形態】(第1の実施形態)以下、本発明の第1の実施形態に係る半導体装置における銅合金配線及びその製造方法について、図1(a)～(c)及び図2(a)、(b)を参照しながら説明する。

【0034】まず、図1(a)に示すように、半導体基板101の上に堆積された層間絶縁膜102にコンタクトホール103及び配線用凹状溝104を形成する。コンタクトホール103の径は0.25μm程度とする。

20 【0035】次に、図1(b)に示すように、コンタクトホール103及び配線用凹状溝104を含む層間絶縁膜102の上に全面に亘って、半導体基板101との密着性を向上させる下層のTi膜及びCuの層間絶縁膜102及び半導体基板101への拡散を防止する上層のTiN膜よりなるTiN/Ti膜105を堆積する。

30 【0036】次に、Cu-1重量%Agよりなる銅合金のターゲットを用いるスパッタ法により、TiN/Ti膜105の上に40nmの膜厚を有する銅合金膜106を堆積する。この場合、スパッタ法は一般に段差被覆性が良くないので、銅合金膜106によって、0.25μm程度の径の小さいコンタクトホール103及び配線用凹状溝104を完全に埋め込むことはできない。その理由は、スパッタ法により銅合金膜106を堆積すると、径の小さいコンタクトホール103の開口部の近傍において銅合金膜106がオーバーハングしてしまうからである。

【0037】そこで、前記のスパッタ法の後に段差被覆性に優れたCVD法又はメッキ法を行なって、図1

(c)に示すように、銅合金膜106の上に、例えば銅合金膜106の約11倍の厚さ(480nm)を有する銅膜107を堆積する。これにより、コンタクトホール103及び配線用凹状溝104は銅合金膜106及び銅膜107によって完全に埋め込まれる。CuのCVD法では表面の平坦性を向上させるために、また、メッキ法として電解メッキを用いる場合には下地に低抵抗なCu膜が必要であるために、CVD法又はメッキ法では銅合金膜106を下地に用いることが必要である。

40 【0038】次に、400℃程度の熱処理を行なって、銅合金膜106のAgをCu膜107に拡散させることにより、図2(a)に示すように、Cu-0.085重量%Agよりなる銅合金膜108を形成する。

50 【0039】ところで、銅合金膜108におけるAgの

含有量については、500℃程度の温度下ではCu中のAgの固溶限は1重量%程度であり、Agをそれ以上含有させるとAgを主成分とする相が銅合金膜108中に局部的に析出する恐れがある。従って、半導体プロセスにおける熱処理の温度は500℃以下であることを考えると、Agの含有量としては1重量%以下が好ましい。

【0040】次に、TiN/Ti膜105及び銅合金膜108に対して例えばCMP法を行なって、層間絶縁膜102の上に露出しているTiN/Ti膜105及び銅合金膜108を除去することにより、図2(b)に示すように、銅合金膜108よりなるコンタクト109及び埋め込み配線110を形成する。その後、埋め込み配線110及び層間絶縁膜102の上に全面に亘って、埋め込み配線110を構成するCuの上方への拡散を防止する窒化シリコン膜111を堆積する。

【0041】第1の実施形態において形成したCu-0.085重量%Agよりなる銅合金膜108の再結晶温度は、純銅の再結晶温度である250℃よりも高く400℃である(堀ほか、日本金属学会誌、p1223, 1981)。再結晶温度が高いということは塑性変形し難いということであるから、銅合金膜108はヒロック及びボイドが生じ難いので、エレクトロマイグレーション耐性が向上することが裏付けられている。

【0042】また、Cu-0.085重量%Agよりなる銅合金膜108においては、Agの濃度は50ppm程度であるため、銅合金膜108の電気伝導率は純銅とほぼ同等の $1.7 \mu\text{ohm} \cdot \text{cm}$ である(J.S.Smart et al., Trans. AIME, 147(1942), 48)。従って、銅合金膜108の電気伝導率は純銅に比べて低下しない。これに対して、既に知られているCu-Zr合金膜よりなる埋め込み配線では、Zrが50ppm程度添加されると電気伝導度が $2.2 \mu\text{ohm} \cdot \text{cm}$ に上昇してしまうと共に、ZrとCuとが反応してCuZr₂化合物を作り易いという問題があるので、第1の実施形態のように、Cu-Agよりなる銅合金膜108の方が有利である。

【0043】以上説明したように、銅合金膜108よりなる埋め込み配線110は導電性及びエレクトロマイグレーション耐性の両方において優れている。

【0044】ところで、現在の技術では、CVD法又はメッキ法によってCu-Agよりなる銅合金膜を堆積することができないと共に、スパッタ法によって径の小さいコンタクトホールに銅合金膜を完全に埋め込むことはできない。そこで、第1の実施形態においては、スパッタ法によりCu-1重量%Agよりなる銅合金膜106を薄く堆積すると共に銅合金膜106の上にCVD法又はメッキ法により銅膜107を厚く堆積した後、熱処理を施して銅合金膜106のAgを銅膜107に拡散させることにより、Cu-0.085重量%Agよりなる銅合金膜108を形成している。

【0045】また、スパッタ法により堆積した銅合金膜

106は(111)面に配向する性質があるため、銅合金膜106上にCVD法又はメッキ法により堆積される銅膜107は、下地の影響を受けて(111)面に配向する。従って、面内原子間隔が銅合金膜106の(111)面とほぼ等しい銅膜107をCVD法又はメッキ法により堆積することができる。また、CuはAlと同じfcc結晶であるため、最密面である(111)面が断線のきっかけとなり易いが、銅膜107の(111)面が半導体基板11の主面と平行に配向しているので、銅合金膜108よりなる埋め込み配線110は断線し難くなり、エレクトロマイグレーション耐性がさらに向上するという利点もある。

【0046】尚、第1の実施形態においては、Cu-1重量%Agよりなる銅合金膜106と銅膜107とをほぼ完全に反応させて、Cu-0.085重量%Agよりなる銅合金膜108を形成したが、Cu-1重量%Agよりなる銅合金膜106を堆積する代わりに、TiN/Ti膜105を構成する上層のTiN膜にAgを含有させてもよい。この場合には、銅膜107をスパッタ法により堆積された下層の銅膜とCVD法又はメッキ法により堆積された上層の銅膜とから構成することが膜堆積工程上好ましい。

【0047】また、層間絶縁膜102及び半導体基板101の表面をアンモニアプラズマ等で処理してCuの拡散を防止しておけば、TiN/Ti膜105のような拡散防止膜を堆積しなくてもよい。

【0048】また、第1の実施形態においては、銅合金膜106として、新規に提案したCu-Ag合金を用いたが、導電率が多少低くともよい場合には、Cu-Sn合金、Cu-Mg合金又はCu-Zr合金等を用いてもよい。

【0049】(第2の実施形態)以下、本発明の第2の実施形態に係る半導体装置における銅合金配線及びその製造方法について、図3(a)～(c)及び図4(a)～(c)を参照しながら説明する。

【0050】まず、図3(a)に示すように、半導体基板201の上に堆積された層間絶縁膜202にコンタクトホール203及び配線用凹状溝204を形成する。コンタクトホール203の径は0.25μm程度とする。

【0051】次に、図3(b)に示すように、コンタクトホール203及び配線用凹状溝204を含む層間絶縁膜202の上に全面に亘って、半導体基板201との密着性を向上させる下層のTi膜及びCuの層間絶縁膜202及び半導体基板201への拡散を防止する上層のTiN膜よりなるTiN/Ti膜205を堆積する。

【0052】次に、純銅よりなるターゲットを用いるスパッタ法により、TiN/Ti膜205の上に下層の銅膜206を堆積した後、CVD法又はメッキ法により、図3(c)に示すように、下層の銅膜206の上に上層の銅膜207を堆積する。この場合、下層の銅膜206

10

20

30

40

50

と上層の銅膜207との膜厚としては925nmとする。これにより、コンタクトホール203及び配線用凹状溝204は下層及び上層の銅膜206、207により完全に埋め込まれる。

【0053】次に、スパッタ法により、図4(a)に示すように、上層の銅膜207の上に例えば75nmの膜厚を有するニオブ膜208を堆積する。

【0054】次に、ニオブ膜208の表面酸化を防ぐため、水素を含んだ還元雰囲気中で400℃程度の熱処理を行なって、ニオブ膜208のNbを下層及び上層の銅膜206、207に拡散させることにより、図4(b)に示すように、Cu-7.2重量%Nbよりなる銅合金膜209を形成する。この場合、下層及び上層の銅膜206、207の膜厚が925nm、ニオブ膜208の膜厚が75nmであって、Cuの密度が8.93、Nbの密度が8.56であるから、体積比×密度の積の割合に基づき、銅合金膜209はCu-7.2重量%Nbよりなる。

【0055】ところで、銅合金膜209におけるNbの含有量については、500℃程度の温度下ではCu中のNbの固溶限は0.4重量%程度であり、Nbをそれ以上含有させるとNbを主成分とする相が銅合金膜209中に局所的に析出する恐れがある。従って、半導体プロセスにおける熱処理の温度は500℃以下であることを考えると、Nbの含有量としては0.4重量%以下が好ましい。

【0056】次に、TiN/Ti膜205及び銅合金膜209に対して例えばCMP法を行なって、層間絶縁膜202の上に露出しているTiN/Ti膜205及び銅合金膜209を除去することにより、図4(c)に示すように、銅合金膜209よりなるコンタクト210及び埋め込み配線211を形成する。その後、埋め込み配線211及び層間絶縁膜202の上に全面に亘って、埋め込み配線211を構成するCuの上方への拡散を防止する窒化シリコン膜212を堆積する。

【0057】Cu-7.2重量%Nbよりなる銅合金膜209の電気伝導率は純銅よりも若干高い $2.0\mu\Omega\cdot\text{cm}$ 程度である(K.R.Karasek et al., J. Appl. Phys. 52(1991), 1370)。しかも、図8の特性図に示されるように、Cu-Nb膜は引っ張り強さが大きくてエレクトロマイグレーション耐性も強くなるものと考えられる。従って、銅合金膜209よりなる埋め込み配線211は導電性及びエレクトロマイグレーション耐性の両方において優れている。

【0058】第2の実施形態においては、段差被覆性に優れたCVD法又はメッキ法により堆積した平坦な上層の銅膜207の上にニオブ膜208を堆積するため、ニオブ膜208の膜厚を大きくできるので、ニオブ膜208を構成するNbを確実に下層及び上層の銅膜206、207に拡散させることができる。

【0059】尚、第2の実施形態においては、下層及び上層の銅膜206、207を構成するCuとニオブ膜208を構成するNbとをほぼ完全に反応させて、Cu-7.2重量%Nbよりなる銅合金膜209を形成したが、これに代えて、熱処理後にニオブ膜208が残存するようにしても、該ニオブ膜208を銅合金膜209と共にCMP法により除去することができる。

【0060】また、層間絶縁膜202及び半導体基板201の表面をアンモニアプラズマ等で処理してCuの拡散を防止しておけば、TiN/Ti膜205のような拡散防止膜を堆積しなくてもよい。

【0061】(第3の実施形態)以下、本発明の第3の実施形態に係る半導体装置における銅合金配線及びその製造方法について、図5(a)～(d)及び図6(a)～(c)を参照しながら説明する。

【0062】まず、図5(a)に示すように、半導体基板301の上に堆積された層間絶縁膜302にコンタクトホール303及び配線用凹状溝304を形成する。コンタクトホール303の径は0.25μm程度とする。

【0063】次に、図5(b)に示すように、コンタクトホール303及び配線用凹状溝304を含む層間絶縁膜302の上に全面に亘って、半導体基板301との密着性を向上させる下層のTi膜及びCuの層間絶縁膜302及び半導体基板301への拡散を防止する上層のTiN膜よりなるTiN/Ti膜305を堆積する。

【0064】次に、スパッタ法により、TiN/Ti膜305の上の下層の銅膜306を堆積した後、CVD法又はメッキ法により、図5(c)に示すように、下層の銅膜306の上に上層の銅膜307を堆積する。これにより、コンタクトホール303及び配線用凹状溝304は下層及び上層の銅膜306、307により完全に埋め込まれる。

【0065】次に、TiN/Ti膜305、下層及び上層の銅膜306、307に対して例えばCMP法を行なって、層間絶縁膜302の上に露出しているTiN/Ti膜305、下層及び上層の銅膜306、307を除去した後、硝酸によるウェットエッチングを上層の銅膜307に対して行なって、図5(d)に示すように、上層の銅膜307の上に空間部を形成する。

【0066】次に、無電解めっき法等により、図6(a)に示すように、上層の銅膜307の上に選択的に銀膜308を堆積する。

【0067】次に、銀膜308の表面酸化を防ぐため、水素を含んだ還元雰囲気中で400℃程度の熱処理を行なって、銀膜308のAgを下層及び上層の銅膜306、307に拡散させることにより、図6(b)に示すように、Cu-0.1重量%Agよりなる銅合金膜309を形成すると共に、該銅合金膜309よりなるコンタクト310及び埋め込み配線311を形成する。この場合、Cu-0.1重量%Agよりなる銅合金膜309が

形成されるように、下層及び上層の銅膜306、307と銀膜308との膜厚を調整する。

【0068】次に、図6(c)に示すように、埋め込み配線311及び層間絶縁膜302の上に全面に亘って、埋め込み配線311を構成するCuの上方への拡散を防止する窒化シリコン膜312を堆積する。

【0069】第3の実施形態によると、熱処理により反応させる領域が上層の銅膜307と選択的に堆積された銀膜308とに限られるので、層間絶縁膜302の上に堆積された膜をCMP法により除去する工程が容易になる。

【0070】尚、第3の実施形態においては、上層の銅膜307の上に選択的に銀膜308を堆積したが、これに代えて、全面に亘って銀膜308を堆積した後、熱処理を行なって銅合金膜309を形成し、その後、残存する銀膜308をCMP法により除去してもよい。

【0071】(第4の実施形態)以下、本発明の第4の実施形態に係る半導体装置における銅合金配線及びその製造方法について、図7(a)～(c)を参照しながら説明する。

【0072】まず、第3の実施形態と同様にして、半導体基板401の上に堆積された層間絶縁膜402にコンタクトホール及び配線用凹状溝を形成した後、コンタクトホール及び配線用凹状溝を含む層間絶縁膜402の上に全面に亘ってTiN/Ti膜405を堆積する。次に、スパッタ法により、TiN/Ti膜405の上に下層の銅膜406を堆積した後、CVD法又はメッキ法により、下層の銅膜406の上に上層の銅膜407を堆積し、その後、TiN/Ti膜405、下層及び上層の銅膜406、407に対して例えばCMP法を行なって、図7(a)に示すように、層間絶縁膜402の上に露出しているTiN/Ti膜405、下層及び上層の銅膜406、407を除去する。

【0073】次に、図7(b)に示すように、上層の銅膜407及び層間絶縁膜402の上に全面に亘ってアルミナ膜408を堆積する。

【0074】次に、熱処理を行なって、アルミナ膜408を構成するAl₂O₃を下層及び上層の銅膜406、407に拡散させて、図7(c)に示すように、Cu-Al₂O₃よりなる銅合金膜409を形成すると共に、該銅合金膜409よりなるコンタクト410及び埋め込み配線411を形成する。

【0075】第4の実施形態によると、アルミナ膜408が絶縁性を有しているため、除去する必要がないと共にアルミナ膜408を層間絶縁膜として用いることができるので、工程数の低減を図ることができる。

【0076】尚、第1～第4の実施形態においては、銅膜107、207、307、407として純銅を用いたが、これに代えて、Cuに他の金属が含まれてなる銅合金を用いてもよい。

【0077】また、TiN/Ti膜105、205、305、405又は銅膜107、207、307、407を選択CVD法によりコンタクトホール103、203、303及び配線用凹状溝104、204、304の内部にのみ堆積してもよいし、TiN/Ti膜105、205、305、405の代わりに、他の拡散防止膜、例えば、Ta膜、Ta₂N膜又はWN膜等を用いてもよい。

【0078】また、コンタクトホール103、203、303及び配線用凹状溝104、204、304の内部への埋め込みが可能であるならば、スパッタ法+リフロー法又はイオンプレーティング法等の方法によって、銅膜107、207、307を形成してもよい。

【0079】さらに、上層の銅膜207、307、407を堆積する際に、下地の銅膜を必要としない場合には、下層の銅膜206、306、406を省略してもよい。

【0080】

【発明の効果】第1の半導体装置によると、埋め込み配線を構成するCu-Nb合金、Cu-Ag合金又はCu-Al₂O₃合金は引張り強さ及び導電率の両方に優れているため、埋め込み配線の導電率及びエレクトロマイグレーション耐性の両方を向上させることができるので、半導体装置の信頼性が向上する。

【0081】第1の半導体装置において、銅合金がCuに1重量%以下のAgが含まれてなる場合には、半導体プロセスにおける500℃以下の熱処理ではAgを主成分とする相が銅合金中に局所的に析出しないので、析出物によって埋め込み配線の導電率がばらつく事態を回避することができる。

【0082】また、第1の半導体装置において、銅合金がCuに0.4重量%以下のNbが含まれてなる場合には、半導体プロセスにおける500℃以下の熱処理ではNbを主成分とする相が銅合金中に局所的に析出しないので、析出物によって埋め込み配線の導電率がばらつく事態を回避することができる。

【0083】第2の半導体装置によると、第1の半導体装置と同様、埋め込み配線の導電率及びエレクトロマイグレーション耐性の両方を向上させることができると共に、Al₂O₃を含有する絶縁膜を埋め込み配線に拡散させるAl₂O₃の供給源及び絶縁膜として有効に利用することができる。

【0084】第1の半導体装置の製造方法によると、CuにAg、Nb又はAl₂O₃が含まれた銅合金よりなる埋め込み配線をダマシン法又はデュアルダマシン法によって確実に形成することができる。

【0085】第1の半導体装置の製造方法において、層間絶縁膜の上に全面に亘って第1の金属膜を堆積した後、該第1の金属膜の上に全面に亘って第2の金属膜を堆積し、その後、層間絶縁膜の上に露出している第1の

金属膜及び第2の金属膜を除去すると、埋め込み配線を簡易且つ確実に形成することができる。

【0086】第1の半導体装置の製造方法において、スパッタ法により第1の金属膜を堆積した後、CVD法又はメッキ法により第2の金属膜を堆積すると、アスペクト比の高い配線用凹部にも第1及び第2の金属膜を確実に埋め込むことができる。

【0087】第2の半導体装置の製造方法によると、CuにAg、Nb又はAl、O₂が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を確実に形成できると共に、第2の金属膜の表面がほぼ平坦であるため、層間絶縁膜の上に露出している第1の金属膜及び第2の金属膜を例えばCMPにより除去して、配線用凹部に埋め込み配線を形成する工程を容易且つ確実に行なうことができる。

【0088】第3の半導体装置の製造方法によると、CuにAg、Nb又はAl、O₂が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を確実に形成できると共に、層間絶縁膜の上に露出した第1及び第2の金属膜を除去する工程が不要になるので、工程数の増加を招くことなく銅合金よりなる埋め込み配線を形成することができる。

【0089】第4の半導体装置の製造方法によると、CuにAg、Nb又はAl、O₂が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を確実に形成できると共に、第2の金属膜の表面がほぼ平坦であるため、層間絶縁膜の上に露出している第2の金属膜を例えばCMPにより除去して、配線用凹部に埋め込み配線を形成する工程を容易且つ確実に行なうことができる。第2の金属膜として絶縁性のAl₂O₃を用いた場合には、第2の金属膜を除去することなく絶縁膜として用いることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)～(c)は第1の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。

【図2】(a)、(b)は第1の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。

【図3】(a)～(c)は第2の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。

【図4】(a)～(c)は第2の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。

【図5】(a)～(d)は第3の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。

【図6】(a)～(c)は第3の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。

【図7】(a)～(c)は第4の実施形態に係る半導体

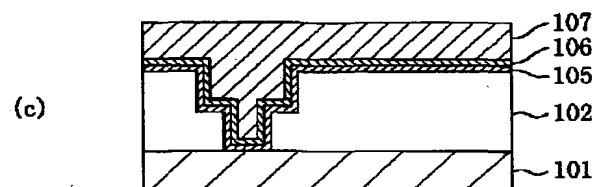
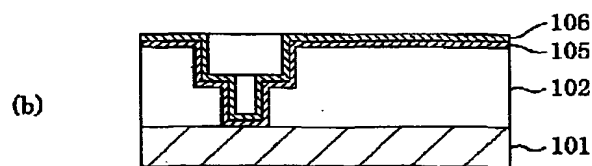
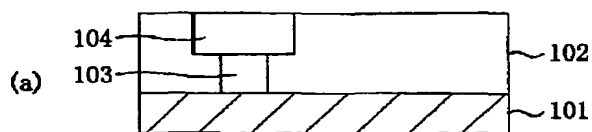
装置の製造方法の各工程を示す断面図である。

【図8】各種の銅合金の引張り強さ及び導電率を示す特性図である。

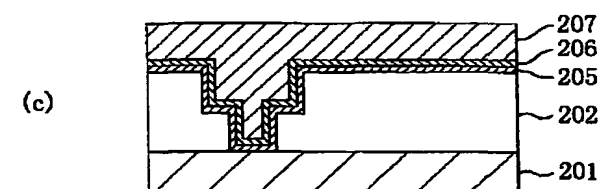
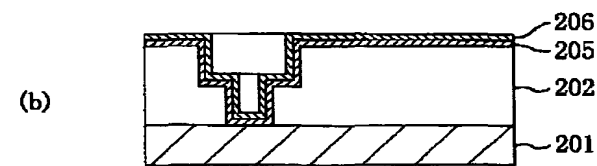
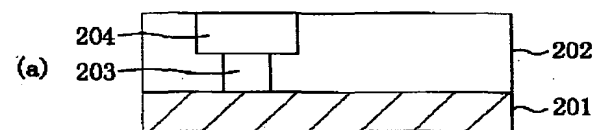
【符号の説明】

- | | |
|-----|----------|
| 101 | 半導体基板 |
| 102 | 層間絶縁膜 |
| 103 | コンタクトホール |
| 104 | 配線用凹状溝 |
| 105 | TiN/Ti膜 |
| 106 | 銅合金膜 |
| 107 | 銅膜 |
| 108 | 銅合金膜 |
| 109 | コンタクト |
| 110 | 埋め込み配線 |
| 111 | 窒化シリコン膜 |
| 201 | 半導体基板 |
| 202 | 層間絶縁膜 |
| 203 | コンタクトホール |
| 204 | 配線用凹状溝 |
| 205 | TiN/Ti膜 |
| 206 | 下層の銅膜 |
| 207 | 上層の銅膜 |
| 208 | ニオブ膜 |
| 209 | 銅合金膜 |
| 210 | コンタクト |
| 211 | 埋め込み配線 |
| 212 | 窒化シリコン膜 |
| 301 | 半導体基板 |
| 302 | 層間絶縁膜 |
| 303 | コンタクトホール |
| 304 | 配線用凹状溝 |
| 305 | TiN/Ti膜 |
| 306 | 下層の銅膜 |
| 307 | 上層の銅膜 |
| 308 | 銀膜 |
| 309 | 銅合金膜 |
| 310 | コンタクト |
| 311 | 埋め込み配線 |
| 312 | 窒化シリコン膜 |
| 401 | 半導体基板 |
| 402 | 層間絶縁膜 |
| 405 | TiN/Ti膜 |
| 406 | 下層の銅膜 |
| 407 | 上層の銅膜 |
| 408 | アルミナ膜 |

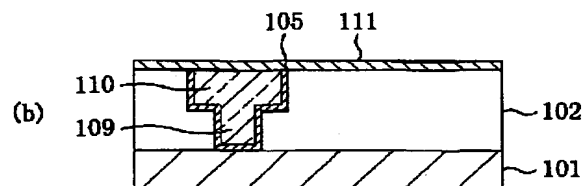
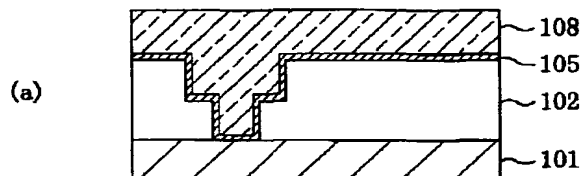
【図1】



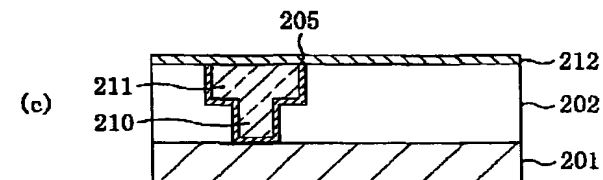
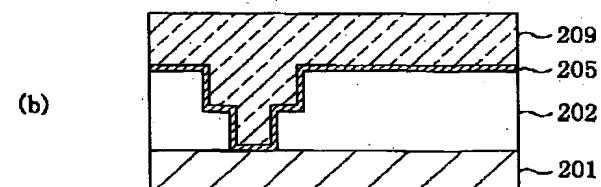
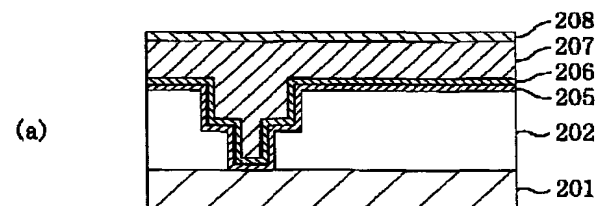
【図3】



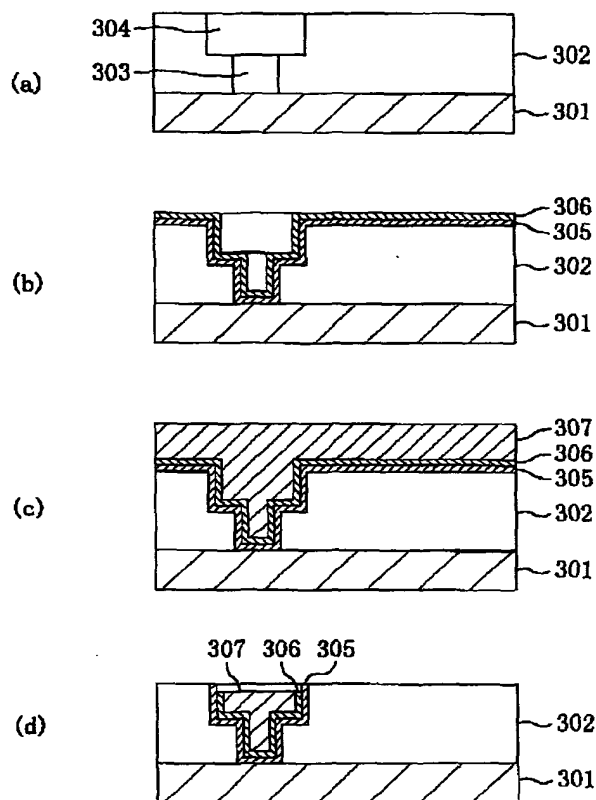
【図2】



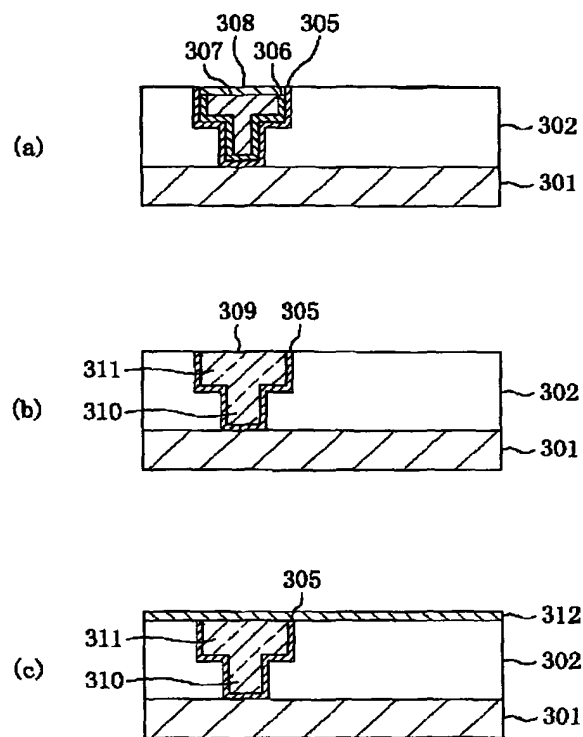
【図4】



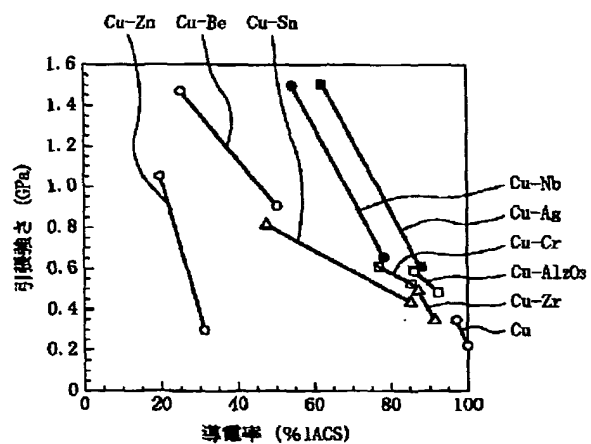
【図5】



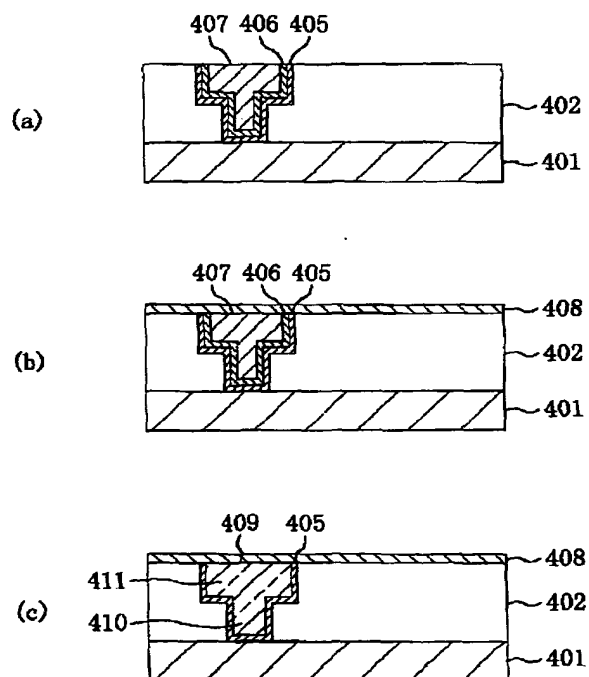
【図6】



【図8】



【図7】



【手続補正書】

【提出日】平成11年1月8日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 埋め込み配線を有する半導体装置であって、

前記埋め込み配線は、 Cu に Al_2O_3 が含有された銅合金よりなることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 埋め込み配線と該埋め込み配線の上に形成された絶縁膜とを有する半導体装置であって、

前記絶縁膜は、 Al_2O_3 を含有し、

前記埋め込み配線は、 Cu に前記 Al_2O_3 が拡散してなる銅合金よりなることを特徴とする半導体装置。

【請求項3】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、

スパッタ法により、前記配線用凹部を含む前記層間絶縁膜の上に全面に亘って Cu に Ag 又は Nb が含有された第1の金属よりなり表面が(111)面に配向している第1の金属膜を形成することにより、前記配線用凹部の壁面に前記第1の金属膜を形成する第1の金属膜形成工程と、

CVD 法又はメッキ法により、前記第1の金属膜の上に全面に亘って Cu からなるか又は Cu を主成分とする第2の金属よりなり表面が(111)面に配向している第2の金属膜を前記配線用凹部が埋め込まれるように形成する第2の金属膜形成工程と、

前記半導体基板に対して熱処理を行なって前記第1の金属膜に含まれている Ag 又は Nb を前記第2の金属膜に拡散させた後、前記層間絶縁膜の上に露出している前記第1の金属膜及び第2の金属膜を除去することにより、 Cu に Ag 又は Nb が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項4】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、

CVD 法又はメッキ法により、前記配線用凹部を含む前記層間絶縁膜の上に全面に亘って Cu からなるか又は Cu を主成分とする第1の金属よりなり第1の金属膜を前記配線用凹部が埋め込まれるように形成する第1の金属膜形成工程と、

前記第1の金属膜の上に全面に亘って Ag 又は Nb を含有する第2の金属よりなり第2の金属膜を形成する第2の金属膜形成工程と、

前記半導体基板に対して熱処理を行なって前記第2の金属膜に含まれている Ag 又は Nb を前記第1の金属膜に拡散させる拡散工程と、

前記層間絶縁膜の上に露出している前記第1の金属膜及び第2の金属膜を除去して、 Cu に Ag 又は Nb が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項5】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、 CVD 法又はメッキ法により、前記配線用凹部を含む前記層間絶縁膜の上に全面に亘って Cu からなるか又は Cu を主成分とする金属膜を前記配線用凹部が埋め込まれるように形成する金属膜形成工程と、

前記金属膜の上に全面に亘って Al_2O_3 を含有する膜を形成する膜形成工程と、

前記半導体基板に対して熱処理を行なって前記 Al_2O_3 を含有する膜に含まれている Al_2O_3 を前記金属膜に拡散させる拡散工程と、

前記層間絶縁膜の上に露出している前記金属膜及び Al_2O_3 を含有する膜を除去して、 Cu に Al_2O_3 が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項6】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、

前記配線用凹部に Cu からなるか又は Cu を主成分とする第1の金属よりなり第1の金属膜を該第1の金属膜の上に空間部が残存するように形成する第1の金属膜形成工程と、

前記第1の金属膜の上に Ag 又は Nb が含有された第2の金属よりなり第2の金属膜を前記空間部が埋め込まれ且つ前記層間絶縁膜の上に露出しないように形成する第2の金属膜形成工程と、

前記半導体基板に対して熱処理を行なって前記第2の金属膜に含まれている Ag 又は Nb を前記第1の金属膜に拡散させることにより、 Cu に Ag 又は Nb が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項7】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、

前記配線用凹部に Cu からなるか又は Cu を主成分とする金属膜を該金属膜の上に空間部が残存するように形成する金属膜形成工程と、

前記金属膜の上に Al_2O_3 を含有する膜を前記空間部が埋め込まれ且つ前記層間絶縁膜の上に露出しないように形成する膜形成工程と、

前記半導体基板に対して熱処理を行なって、前記 Al_2O_3 を含有する膜に含まれている Al_2O_3 を前記金属膜に拡散させることにより、 Cu に Al_2O_3 が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形

成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項8】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、

前記配線用凹部にCuからなるか又はCuを主成分とする第1の金属よりなる第1の金属膜を前記配線用凹部が埋め込まれ且つ前記層間絶縁膜の上に露出しないように形成する第1の金属膜形成工程と、

前記第1の金属膜の上にAg又はNbを含有する第2の金属よりなる第2の金属膜を形成する第2の金属膜形成工程と、

前記半導体基板に対して熱処理を行なって前記第2の金属膜に含まれているAg又はNbを前記第1の金属膜に拡散させることにより、CuにAg又はNbが含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の

製造方法。

【請求項9】 半導体基板上に堆積された層間絶縁膜に配線用凹部を形成する凹部形成工程と、

前記配線用凹部にCuからなるか又はCuを主成分とする金属膜を前記配線用凹部が埋め込まれ且つ前記層間絶縁膜の上に露出しないように形成する金属膜形成工程と、

前記金属膜の上に Al_2O_3 を含有する膜を形成する膜形成工程と、

前記半導体基板に対して熱処理を行なって前記 Al_2O_3 を含有する膜に含まれている Al_2O_3 を前記金属膜に拡散させることにより、Cuに Al_2O_3 が含有された銅合金よりなる埋め込み配線を形成する埋め込み配線形成工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。